



SS8550 TRANSISTOR (PNP)

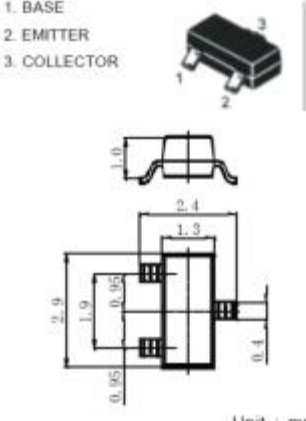
高频三极管

简介： 主要用于电子设备的一般用途放大器，中等功率驱动器及中速开关应用等

特点： ★ 优越的HFE 线性，电流大。 ★ SS8550 与SS8050 互补。

产品标准：

最大规格 (Ta=25℃) SOT-23

参数	符号	规格	单位	SOT-23 1. BASE 2. EMITTER 3. COLLECTOR  Unit : mm
集电极-基极电压	V_{CBO}	-40	V	
集电极电流	I_C	-1000	mA	
集电极功耗	P_C	625	mW	
结温	T_j	150	℃	

点特性 (Ta=25℃)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C=-0.1mA, I_E=0$	-40			V
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C=-1mA, I_B=0$	-40			V
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_E=-0.1mA, I_C=0$	-5			V
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=-35V, I_E=0$			-0.1	μA
集电极-发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE}=-20V, I_B=0$			-3.0	μA
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=-4V, I_C=0$			-0.1	μA
直流电流增益	hFE	$V_{CE}=-1V, I_C=-100mA$	85		400	
		$V_{CE}=-1V, I_C=-1mA$	60			
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-800mA, I_B=-80mA$			-0.5	V
基极-发射极饱和电压	$V_{BE(sat)}$	$I_C=-800mA, I_B=-80mA$			-1.2	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=-6V, I_C=-20mA$ $f=30MHz$	150			MHz

HFE 分档范围: (允许测试误差 10%)

Y2
200-400



特性曲线

